

ICSICT2018

(IEEE 14th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology)

出張報告

群馬大学 松田順一 2018年11月6日

主催 IEEE 北京セッション

協賛 北京大学、復旦大学、他

開催日 2018年10月31-11月3日(10月31日はチュートリアル、11月1日から発表)

場所 中国(青島) Huangdao Sheraton Hotel

(出張期間は10月28日(日):成田前泊~11月4日(日):成田到着)

論文採択率は約75%で、以下の表に詳細を示します。

全投稿論文数	586
全採択論文数	454
採択率(全論文)	77%

投稿論文数(Regular+Poster)	475
採択論文数(Regular+Poster)	343
採択率(Regular+Poster)	72%

キーノート論文数	8
招待論文数	103
レギュラー論文数	189
ポスター論文数	154
全論文数	454

本国際学会は、中国の科学技術を推進するために、海外から著名な先生を多く招待して講演して貰い、また学生に国際学会という場での発表の機会を与え、将来を担う学生の教育の一環として位置づけられている印象を受けました。

日本からは、群馬大学(小林研および尹友(イン ユウ)先生)から18名(学生13名、教員5名)が参加し、13件の口頭発表(内2件は小林先生の招待講演、1件は尹友先生の招待講演)を行いました。また、広島大学から3件、東京大学から2件、東工大から2件、東北大学から2件、京都大学から1件、パナソニックから1件、ソシオネクストから1件、ルネサスエレクトロニクスから1件、東芝メモリから1件の招待講演がありました。更に、京都大学からポスターセッションで1件の発表がありました。

群馬大学からレギュラー論文の発表を二日目に9件、三日目に1件行いました。私は二日目の午後“Wide SOA and High Reliability 60-100 V LDMOS Transistors with Low Switching Loss and Low Specific On-Resistance”の題で発表し、6件の質問がありました。(1)Harshの意味は何か?⇒高電圧、高温度、(2)提案構造を作るプロセスのコストは高いか?⇒従来の0.35 μ mプロセスで作れるので低コスト、(3)Dual RESURFの効果?⇒ゲート端で電界を弱める効果あり、(4)提案構造ではMiller効果でノイズの問題はないか?⇒ノイズの問題はない、(5)電流レベルはどのくらいになるか?⇒ $I_{DS}-V_{DS}$ 特性の図の縦軸の数値

と単位を説明、(6)Turn-on 時に提案構造ではゲート電流にプラトー領域ができない理由？
⇒ V_{DS} が低くなると V_{DS} の低下に対し真性 MOSFET のドレイン電圧の低下の割合が下が
ることに起因（実質的にゲートとドレイン間の容量が増加）。

三日目の最後の Closing Banquet で、8 人の学生が Student Paper Award を頂くことが
でき、その中の一人に小林研の孫さんが選ばれました。

青島到着の翌日（10 月 30 日）に皆さんと一緒にハイアールの創新生活展と文化展を見学
し、その翌日（10 月 31 日）に青島観光（栈橋散策と青島海底世界）に行きました。

会場でトロント大学の Wai Tung Ng 教授に久しぶりにお会いし、小林先生、小堀先生、
イン先生を含めてディナーを共にし、楽しい時間を過ごせました。この時、桑名先生を Ng
教授に紹介しました。Ng 教授は招待講演で本学会に参加されており、学会終了後、Ng 教
授から「GaN HEMTs のゲートドライバー」に関する発表資料を頂くことができました。
また、Banquet の時に桑名先生と私は小林先生から著名な UCLA の Jason Woo 教授を紹介
して頂きました。

群馬大学から参加した学生の皆さんは、準備が大変だったと思いますが、海外での国際学
会ということで非常に良い経験をさせて頂いたものと思います。私も学生の皆さんと一緒
に有意義な経験をさせて頂きました。有難う御座いました。



